JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

# SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION:A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connection pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

**卯特許出願公開** 

# 母公開特許公報(A)

平4-27145

@Int. Cl. 5

塗別記号

庁内整理番号

**@**公開 平成 4 年(1992) 1 月30日

H 01 L 23/29

H 01 L 23/36 7220-4M

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

半導体装置 会発明の名称

> **204** 顧 平2-132272

❷出 顋 平2(1990)5月22日

仍発

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエブソン株式 の出 類 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 鈴木 喜三郎 外1名 70代理人

1. 発明の名称

半速体容量

#### 2.特許請求の製団

半導体素子の電弧とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 素子から発生する熱を放出する放船板と共に樹脂 等で封止してなる半導体装置において、前記放船 板を装置上下部もしくは内部に複数改有すること を特徴とする半導体装置。

## 3.発明の詳細な説明

【遊集上の利用分野】

半導体装置の構造にかかり。さらに詳しくは放 船板を有する半導体装置に関する。

### [ 従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き当しのため、金額がKよりリードフレーム4 と接続されている。この半導体チップ2。金糠5 の保護を目的として、通常樹脂1Kて對止されて いる。また、半導体チップ2からの熱を放出する ため、名雅方法が取られている。

第4回(a)は放熱フィン形パッケージの新面 を示した図であるが、第4図(a)では、半導体 チョブ2搭載器(以下ダイパット部と称する)を パッケージ質面部からフィン状に算出させ放助性 を向上させたものである。放熟フィン10は、リ ードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は放熱板内蔵ペッケージ新面を示 した図であるが、第4図(1)では、ダイペット 郵面観を広く取りパッケージ内部に対止すること で放熟性を向上させる。放熱板11は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板貫出形パッケージ前面を 示した固であるが、第4図(c)では、ダイバッ ト型を思くし、パッケージ表面に裏出させ放射性 を向上させたものである。放熱質12は、リード

と垂直方向に出されている。

現在、これらのうち放無性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

#### [発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集酸化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図( \* )は、放熱フィン10を用いて放熱性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレイアクト上のロスが多く、多端子出力の半導体チップには不適である。また、放熱フィン10がパッケージを接断しているため、樹脂1と放熱フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図( 4 )では、放無板11がパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回( a ) に比べ、リードレイアットへのロスがなく改善されている。しかし、放熱板11が放無性の思い樹脂1にて包まれているため高い放無特性が見込めない。また、樹脂1と放熱板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(c)では、放無板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放無特性を持ってあり、放無板12はリードフロとができる。しかし、放無板12はリードは接着されているのみであるため、機成12に対してある。また、機関12にの関係を全、放無は12にへの機関があった。また、機関12にいう問題との密着性低下による品質トラブルという問題とのあった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い放熱特性及び放熱板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 盤を提供することにある。

♪が*良*けられており、この凸型ピンゟ♪を使用し

#### [課題を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体業子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体装置において、前配放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

#### [美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回( a ) は、半導体装置の所面図であり、半導体チェブをは下面放 熱低5 A に直接接着されており、上下の放熱板5 a 、5 A は放熱板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1四( b ) は、下面放 熱板5 A とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブを1000 のレイアウトを示している。 下面放熱板5 A には、結合ビンとして凸型ビン 6 リードフレーム 4 の固定を行なう。下面放為板5 1とリードフレーム4の固定後、半導体チップ2 及び金額3の接合を行なう。第1回( c.) は、上 面放熱仮5 4 リードフレーム 4 下面放熱板 5 4 の固定方法を示したものである。金融5Kよる袋 姓林丁曼、下面放熱板5 4 の凸ピン 4 4 化上面放 熱板5mの凹ピン64を合わせ、上下放熱板5c 。5.4を結合固定する。第1.因(4.)は、対止の 罪の新菌園である。上下の放熱板5 € , 5 ♪は、 それ石れ対止会型の上型フェ下型フォド乗し、会 型クランプ時に全型内に固定される。このため、 樹脂住入の髪の圧力による放熱板 5 4 。 5 4 の機 きがなく安定した品質が確保される。また、<u>故</u>島 仮5 a\_, 5 bは樹脂! との装着力のみではなく。 総合ビン<u>6</u>化より調定されているため。密着性化 おいても向上される。さらに、放熱板が複数構造 となっているため飲熱効果が商上される。。

第2回。第3回に、位の実施例を示す。第2回 は上下放射数8 c。8 d K 加えダイベット部に8 り、8 4 と 8 りの間にさらに放為板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 3 回では上下放 熱板 9 a 。9 c の形状を変えダイパット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合固 定方法も用途に応じて、接着,カンメ等可能であ る。また、放熱板の素材についても、金属。セラ リック・機関でも良い。

#### [発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チェブから発せられる熱を放出する高い放熱性を得られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

### 4.図面の簡単な説明

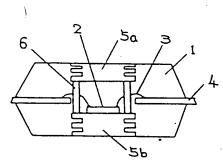
第1回( 4)は、本発明を示す前面図。第1回 ( 4)は放熱板とリードフレームの位置関係を示

- 7 4 - 對止下型
- 8 4 - 放熱板
- 8 4 - 放熱板
- 8c--放船板
- 5 4 - 放船板
- 9 4 - 放熱板
- タカーー放船板
- 9 c - 放船板
- 1 0 - 放船フェン
- 11---拉熱板
- 1 2 - 放熱板

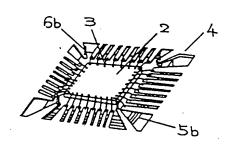
以上

出票人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木宮三郎(依1水) した平面図。第1図(c)は、上下放無板とりードフレームの固定方法を示した新面図。の位置内での全型と放無板を登録所面図。第2図は、放無板を三枚を使用した実施側新面図。第4図(a)は、放血の水を使用した実施側新面図。第4図(a)は、新面図。第4回(a)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。第4回(c)は、新面図。

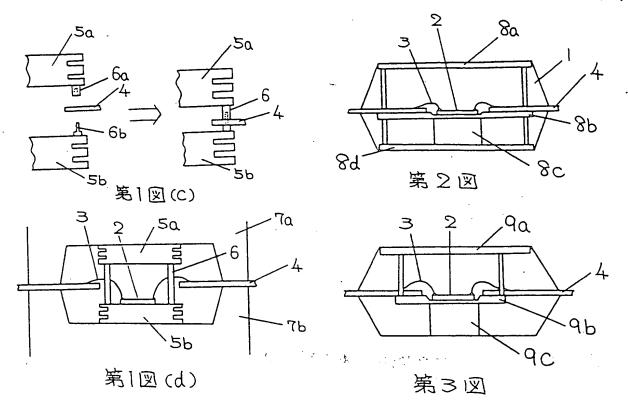
- 1 - 樹 窟
- 2---半導体チップ
- 5---
- 4---リードフレーム
- 5 4 - 放熱板
- 5 4 - 放熱板
- 6 --- 結合ピン
- 6 4 - 凹ピン
- 6 4 - ひピン
- 7 @ -- 對止上型

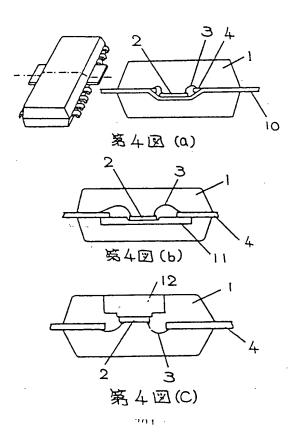


第1図(a)



第1四(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)